

(2) KBBF 結晶による波長変換技術を用いた深紫外光の発生に対する技術的貢献

半導体露光装置用では「ムーアの法則」による半導体の高集積化のために、より短波長の光源が求められる。図 2 に示すように光源の短波長化と高集積化(微細化)は年とともに着実に進んできた。その結果、2000 年代には現存する非線形結晶では発生できない短波長領域のレーザー光源が模索された。

折しも中国科学院の陳博士らが開発した KBBF と称する新しい非線形結晶が真空紫外域(200 nm 以下)の波長変換に適応できるものとして登場した。この結晶を用いて日中共同研究として、次なるトレンドと目されていた F_2 リソグラフィ(波長 157 nm)の発生に筆者は挑戦し、高出力チタンサファイアレーザーの 5 次高調波として発生を成功させた(3)。この光源は非線形結晶による波長変換を 4 回行う複雑な光学系であり、緻密で根気強い実験の成果であった。

一方で、物性科学における強力な研究手法である光電子分光法の分野でも、より高分解能な測定を目指して、ヘリウムランプに代わる、新たな光源が求められていた。真空紫外域への波長変換が可能な KBBF 結晶を利用すれば光電子分光用光源に適用できると考え、筆者はその光源開発に着手し、波長 200 nm で W(ワット)級の高出力な深紫外光発生に成功した(4)。光電子分光用光源としては出力だけでなく、高分解能化のためにレーザー光の狭帯域化と、光電子分光における空間電荷効果の抑制のための高繰り返し化を図り、光子エネルギー 7 eV(波長 177 nm)での真空紫外光の発生を実現し、超高分解能レーザー光電子分光用のための光源利用が開始された。

以上、筆者の学位取得に繋がるとともに、研究の支援に大きく貢献した光源開発について紹介した。

- (3). T. Kanai, T. Kanda, T. Sekikawa, and S. Watanabe
“Generation of VUV light below 160nm in KBBF crystal by the 5th harmonic of a single-mode Ti:sapphire laser” J. Opt . Soc. Am. B **21**, 370-375 (2004).
- (4). T. Kanai, X. Wang, S. Adachi, S. Watanabe, and C. Chen
“Watt-level tunable deep ultraviolet light source by a KBBF prism-coupled device,” Opt. Express, **17**, 8696

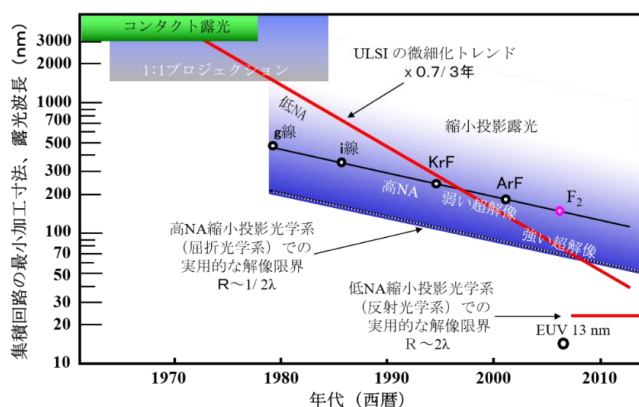


図 2：半導体露光装置(ステッパー)の露光用光源の年代別推移。光源の短波長化により、最小加工寸法の縮小が実現してきた(ナトリウム g 線：589 nm、ナトリウム i 線：365 nm、KrF レーザー：248 nm、ArF レーザー：193 nm、 F_2 レーザー：157 nm)。